# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

10-163211

(43) Date of publication of application: 19.06.1998

(51)Int.Cl.

H01L 21/321

(21)Application number : **08–321628** 

(71)Applicant: FUJITSU LTD

(22)Date of filing:

02.12.1996

(72)Inventor: MIZUKOSHI MASATAKA

YAMAGUCHI ICHIRO

YOSHIKAWA MASAHIRO

OTAKE KOKI KASAI JUNICHI

# (54) MANUFACTURE OF BUMP FORMING PLATE MEMBER AND BUMP FORMATION

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To form deeper holes of a bump forming plate member, and form bumps having a sufficiently large size which are arranged at fine pitches in an electronic components by using the bump forming plate member by performing anisotropic etching and isotropic etching to a crystalline plate, in the manufacturing method of a bump forming plate member and the bump forming plate member.

SOLUTION: A mask 14 is formed on a crystalline plate 10, a plurality of holes 16 are formed on the surface of the plate 10 by anisotropically etching the plate 10, and after the anisotropic etching, the holes 16 on the surface of the plate 10 are made deeper by isotropically etching the plate 10. After this isotropic etching, anisotropic etching and isotropic etching may be applied repeatedly.



## **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁(JP)

H01L 21/321

# (12) 公開特許公報(A)

## (11)特許出願公開番号

# 特開平10-163211

(43)公開日 平成10年(1998) 6月19日

(51) Int.Cl. 6

識別記号

FΙ

H01L 21/92

604F

審査請求 未請求 請求項の数14 OL (全 9 頁)

(21)出顧番号

(22)出顧日

特願平8-321628

平成8年(1996)12月2日

(71) 出頭人 000005223

宮士通株式会社

神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番

1号

(72) 発明者 水越 正孝

神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番

1号 富士通株式会社内

(72)発明者 山口 一郎

神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番

1号 富士通株式会社内

(74)代理人 弁理士 石田 敬 (外3名)

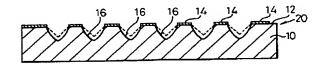
最終頁に続く

# (54) 【発明の名称】 バンブ形成用板部材の製造方法及びパンプ形成方法

### (57)【要約】

【課題】 バンプ形成用板部材の製造方法及びバンプ形成用板部材に関し、結晶性の板に異方性のエッチング及び等方性のエッチングを行うことにより、バンプ形成用板部材の穴をより深く形成でき、よってバンプ形成用板部材を使用して、電子部品に微細なピッチで配列され且つ十分な大きさをもつバンプを形成することを目的とする。

【解決手段】 結晶性の板10にマスク14を形成し、 該結晶性の板に異方性のエッチングを行って該結晶性の 板の表面に複数の穴16を形成し、該異方性のエッチン グを行った後に該結晶性の板に等方性のエッチングを行って該結晶性の板の表面の穴16をさらに深くすること を特徴とする。この等方性のエッチングを行った後に、 さらに異方性のエッチング及び等方性のエッチングを繰 り返して行うことができる。



2

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 結晶性の板にマスクを形成し、該結晶性の板に異方性のエッチングを行って該結晶性の板の表面に複数の穴を形成し、該異方性のエッチングを行った後に該結晶性の板に等方性のエッチングを行って該結晶性の板の表面の穴をさらに深くすることを特徴とするバンプ形成用板部材の製造方法。

【請求項2】 上記等方性のエッチングを行った後に、 異方性のエッチング及び等方性のエッチングを行うこと を特徴とする請求項1に記載のバンプ形成用板部材の製 造方法。

【請求項3】 前記結晶性の板の穴の先端に嘴状の元の 穴よりも細い穴を形成することを特徴とする請求項1に 記載のバンプ形成用板部材の製造方法。

【請求項4】 前記結晶性の板の穴のリップ部のある表面とは反対側の表面を研削し、前記穴の先端が該反対側の表面に露出するようにすることを特徴とする請求項1 又は2に記載のバンプ形成用板部材の製造方法。

【請求項5】 結晶性の板の表面にマスクを形成し、該結晶性の板に異方性のエッチングを行って該結晶性の板の表面に複数の穴を形成し、該結晶性の板を型としてレプリカを作成し、該レプリカを型として該穴と同様の穴を有する金属のバンプ形成用板部材を形成することを特徴とするバンプ形成用板部材の製造方法。

【請求項6】 前記異方性のエッチングを行った後で金属のバンプ形成用板部材を形成する前に、該結晶性の板に等方性のエッチングを行って該結晶性の板の表面の穴をさらに深くすることを特徴とする請求項5に記載のバンプ形成用板部材の製造方法。

【請求項7】 前記等方性のエッチングを行った後で金 30 属のバンプ形成用板部材を形成する前に、異方性のエッチング及び等方性のエッチングを行うことを特徴とする 請求項6に記載のバンプ形成用板部材の製造方法。

【請求項8】 前記金属のバンプ形成用板部材を形成した後に、該金属のバンプ形成用板部材の表面を研削し、前記穴の先端が反対側の表面に露出するようにしたことを特徴とする請求項5から7のいずれかに記載のバンプ形成用板部材の製造方法。

【請求項9】 該結晶性の板を型としてレプリカを作成する工程において、該レプリカは該結晶性の板の表面にメッキを施す工程からなり、該レプリカはメッキ層からなることを特徴とする請求項5に記載のバンプ形成用板部材の製造方法。

【請求項10】 該レプリカを型として該金属のバンプ 形成用板部材を形成する工程において、該金属のバンプ 形成用板部材は該レプリカの表面にメッキを施す工程からなり、該金属のバンプ形成用板部材はメッキ層からなることを特徴とする請求項9に記載のバンプ形成用板部材の製造方法。

【請求項11】 該金属製のバンプ形成用板部材は四角

錐形の形状の複数の穴を有することを特徴とする請求項 5 に記載のバンプ形成用板部材の製造方法。

【請求項12】 該金属製のバンプ形成用板部材は四角形形状のリップ部と、直線状の最深部の両側に斜面が延びる楔形の底部とを有する形状の複数の穴を有することを特徴とする請求項5に記載のバンプ形成用板部材の製造方法。

【請求項13】 結晶性の板にマスクを形成し、該結晶性の板に異方性のエッチングを行って該結晶性の板の表面に複数の穴を形成し、該異方性のエッチングを行った後に該結晶性の板に等方性のエッチングを行って該結晶性の板の表面の穴をさらに深くすることによって製造されたバンプ形成用板部材を用いてバンプを形成する方法であって、該バンプ形成用板部材の穴にはんだベーストを充填し、該はんだペーストを加熱して形成したはんだボールを電気部材に転写することを特徴とするバンプ形成方法。

【請求項14】 結晶性の板の表面にマスクを形成し、 該結晶性の板に異方性のエッチングを行って該結晶性の 板の表面に複数の穴を形成し、該結晶性の板を型として レプリカを作成し、該レプリカを型として該穴と同様の 穴を有する金属のバンプ形成用板部材を形成することに よって製造されたバンプ形成用板部材を用いてバンプを 形成する方法であって、該バンプ形成用板部材の穴には んだペーストを充填し、該はんだペーストを加熱して形 成したはんだボールを電気部材に転写することを特徴と するバンプ形成方法。

### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は例えば半導体チップ 等の電子部品を印刷回路基板に取り付けるためのはんだ バンプ等のバンプを所定のパターンで形成するためのバ ンプ形成用板部材の製造方法及びバンプ形成方法に関す る。

[0002]

【従来の技術】近年の電子装置の小型化及び軽量化への要求に伴い、ICやLSI等の電子部品は、半導体チップ上に素子が高集積化されて、その入出力端子(端子電極)の数は数百にも及ぶようになっている。このような多端子の電子部品を回路基板上に搭載する方法として、電子部品の表面にはんだバンプ等のバンプを予め形成しておき、そのバンプを回路基板上の電極パッドに容着する方法が知られている。

【0003】従来、電子部品の表面にバンプを予め形成する方法として、メッキ法、蒸着法、転写法などが知られている。図23は、従来のバンプ転写法を示し、電子部品2の表面にバンプ形成用板部材1を使用して電子部品2にはんだを転写するところを示している。電子部品2は所定のパターンで設けられた電極パッド3を有し、

50 バンプ形成用板部材1は電極パッド3と同じパターンで

40

3

設けられた貫通穴4を有する。

【0004】転写時には、電極パッド3と貫通穴4とを位置合わせした状態でバンプ形成用板部材1を電子部品2の上に載せ、スキージ5によりはんだペースト6をバンプ形成用板部材1の貫通穴4に充填する。それから、バンプ形成用板部材1を電子部品2に対して持ち上げると、はんだペースト6がバンプ形成用板部材1の貫通穴4から抜けて電極パッド3へ転写される。そこで、この電子部品2を回路基板(図示せず)の上に載せて加熱すると、電子部品2が回路基板に取りつけられることにな10る。

【0005】図23の転写法の問題点は、バンプ形成用板部材1を電子部品2に対して持ち上げるときに、はんだペースト6がバンプ形成用板部材1の貫通穴4の壁面に付着し、はんだペースト6をバンプ形成用板部材1から電子部品2に転写できないことがあることである。最近のように、電子部品2のピン配列が微細ピッチ化していくにつれて、バンプ形成用板部材1の貫通穴4の断面積が小さくなり、はんだペースト6がバンプ形成用板部材1の貫通穴4から抜けにくくなる。

【0006】図22は、特開平4-263433号公報に記載されているバンプ転写法を示す図である。バンプ形成用板部材1は穴4aを有し、この穴4aは図23の貫通穴4と同様のパターンで形成される。ただし、穴4aは貫通穴ではない。図22の場合にも、図23の場合と同様に、スキージ5(図示せず)によりはんだペースト6をバンプ形成用板部材1の穴4aに充填する。そこで、電子部品2をバンプ形成用板部材1に重ね合わせ、電子部品2をバンプ形成用板部材1を加熱すると、穴4a内のはんだペースト6のはんだ成分が丸くなっては30んだボール6aとなってその一部がバンプ形成用板部材1の表面から突出し、電子部品2をバンプ形成用板部材1の表面から突出し、電子部品2をバンプ形成用板部材1から離子部品2へ転写される。

【0007】この転写法によれば、はんだペースト6が 穴4aから抜けないという問題点はない。しかし、バン プ形成用板部材1の穴4aがその頂部からその底部まで ほぼ一定の断面を有しているので、加熱により形成され たはんだボール6aが穴4aの壁に接触し、電子部品2 をバンプ形成用板部材1から離すときにはんだボール6 aが電子部品2から落下することがある。

【0008】このためには、穴4aの断面積を大きくし、穴4aの深さを小さくし、形成されたはんだボール6aが穴4aの壁に接触しないようにすることが必要である。すると、穴4a間のピッチを大きくしなければならず、電子部品2のピン配列の微細ピッチ化に対応できなくなる。また、バンプ形成用板部材1をステンレス鋼やガラス板等を使用して作る場合、ステレンス鋼やガラス板に穴加工やエッチングを行って穴4aを形成することができる。しかし、微小な穴4aを一定の形状で所定50

のピッチ配列で形成することは難しい。

【0009】図21は、さらに他のバンプ転写法の例を示す図である。バンプ形成用板部材1は穴4bを有し、この穴4bは図22の穴4aと同様のパターンで形成される。そして、この場合にも、スキージ5(図示せず)によりはんだペースト6をバンプ形成用板部材1の穴4bに充填し、加熱してはんだボール6aを形成し、このはんだボール6aがバンプ形成用板部材1から電子部品2(図示せず)に転写される。

【0010】図21に示されるバンプ形成用板部材1は、シリコン等の結晶性の板で作られている。穴4bは結晶性の板に異方性のエッチングを行うことにより形成される。この構成によれば、一定の形状で所定のピッチ配列の穴4bを有するバンプ形成用板部材1を得ることができ、このバンプ形成用板部材1を使用して電子部品2に微細なピッチで配列されたバンプを形成することができる。

【0011】さらに、図21のバンプ形成用板部材1の 穴4bの形状は、その上端部が広く、底部が狭い三角形 20 の断面形状になっているので、はんだボール6aをバン プ形成用板部材1から電子部品2に転写するときに、は んだボール6aが穴4bから容易に抜け出ることがで き、穴4bの壁面に付着することがない。

[0012]

【発明が解決しようとする課題】結晶性の板に異方性のエッチングを行うことにより、穴4bを形成すると、穴4bを一定の微少な形状で一定の微小なピッチで形成することができるが、最終的な穴4bの形状において、穴4bの内面が一定の傾斜面となり、マスク7の開口部(穴4bのリップ部)の寸法Lに対して穴4bの深さDが決まってしまう。電子部品2のピン配列のピッチが小さくなると、穴4bのリップ部の寸法Lが小さくなり、穴4bの深さDはますます小さくなる。その結果、形成されたはんだボール6aが小さくなる。

【0013】さらに、上記穴4bを有するバンプ形成用板部材1は、非常に薄い結晶性の板で作られたものであり、比較的に壊れやすい。しかし、従来は、金属でバンプ形成用板部材1を作ると、微小な穴4bを微小なピッチで形成することができなかった。しかし、価格及び耐久性の面から、金属で作られ且つ微小なピッチで配置された穴4bを有するバンプ形成用板部材1が求められていた。

【0014】本発明の目的は、結晶性の板に異方性のエッチングを行うことにより、穴を有するバンプ形成用板部材を製造する方法において、バンプ形成用板部材の穴をより深く形成でき、よってバンプ形成用板部材を使用して、電子部品に微細なピッチで配列され且つ十分な大きさをもつバンプを形成することができるようにした、バンプ形成用板部材の製造方法を提供することである。

50 [0015]

【課題を解決するための手段】本発明によるバンプ形成 用板部材の製造方法は、結晶性の板にマスクを形成し、 該結晶性の板に異方性のエッチングを行って該結晶性の 板の表面に複数の穴を形成し、該異方性のエッチングを 行った後に該結晶性の板に等方性のエッチングを行って 該結晶性の板の表面の穴をさらに深くすることを特徴と するものである。

【0016】この方法によれば、結晶性の板に異方性の エッチングを行って、一定な形状をもち微小なピッチで 配列された穴を有するバンプ形成用板部材を製造するこ とができ、且つ、さらに異方性のエッチングを行った後 に等方性のエッチングを行うことにより、前記特徴を維 持したままで穴をさらに深くすることができる。好まして くは、上記等方性のエッチングを行った後に、異方性の エッチング及び等方性のエッチングを行う。それによっ て、穴をさらに深くすることができる。

【0017】好ましくは、前記結晶性の板の穴の先端に **嘴状の細い深い穴を形成する。好ましくは、前記結晶性** の板の穴のリップ部のある表面とは反対側の表面を研削 し、前記穴の先端が該反対側の表面に露出するようにす る。これによって、バンプ形成用板部材を使用してバン プを形成する際に、反対側の表面に露出する穴の先端が ガス抜き穴として作用する。

【0018】さらに、本発明によるバンプ形成用板部材 の製造方法は、結晶性の板の表面にマスクを形成し、該 結晶性の板に異方性のエッチングを行って該結晶性の板 の表面に複数の穴を形成し、該結晶性の板を型としてレ プリカを作成し、該レプリカを型として該穴と同様の穴 を有する金属のバンプ形成用板部材を形成することを特 徴とする。この方法によれば、結晶性の板に異方性のエ 30 ッチングを行って該結晶性の板の表面に複数の穴を形成 した場合と同様の穴を有する金属性のバンプ形成用板部 材を得ることができる。

【0019】好ましくは、前記異方性のエッチングを行 った後で金属のバンプ形成用板部材を形成する前に、該 結晶性の板に等方性のエッチングを行って該結晶性の板 の表面の穴をさらに深くする。好ましくは、前記等方性 のエッチングを行った後で金属のバンプ形成用板部材を 形成する前に、異方性のエッチング及び等方性のエッチ

【0020】好ましくは、前記金属のバンプ形成用板部 材を形成した後に、該金属のバンプ形成用板部材の表面 を研削し、前記穴の先端が反対側の表面に露出するよう にした。好ましくは、該結晶性の板を型としてレプリカ を作成する工程において、該レプリカは該結晶性の板の 表面にメッキを施す工程からなり、該レプリカはメッキ 層からなる。

【0021】好ましくは、該レプリカを型として該金属 のバンプ形成用板部材を形成する工程において、該金属 のパンプ形成用板部材は該レプリカの表面にメッキを施 50 チング及び等方性のエッチングを繰り返すことにより、

す工程からなり、該金属のバンプ形成用板部材はメッキ 層からなる。さらに、上記製造方法によって製造された 本発明の金属製のバンプ形成用板部材は、四角錐形の形 状の複数の穴を有することを特徴とするものである。

6

【0022】さらに、上記製造方法によって製造された 本発明の金属製のバンプ形成用板部材は、四角形形状の リップ部を、直線状の最深部の両側に斜面が延びる楔形 の底部とを有する形状の複数の穴を有することを特徴と するものである。こうして製造されたバンプ形成用板部 10 材を用いてバンプを形成する方法は、該バンプ形成用板 部材の穴にはんだペーストを充填し、該はんだペースト を加熱して形成したはんだボールを回路基板等の電気部 材に転写することを特徴とするものである。

#### [0023]

【発明の実施の形態】図1から図4は本発明の第1実施 例のバンプ形成用板部材の製造方法を示す図である。図 1においては、結晶性の板であるシリコン基板10を準 備し、シリコン基板10の表面12にマスク14を設け る。マスク14はシリコン基板10の表面12に形成さ れた酸化膜 (SiO2) や窒化膜 (SiN) 等からな 20 り、フォトリソグラフィプロセスによって開口部を有す るマスクを形成する。すなわち、例えば酸化膜の上にレ ジストを塗布し、マスクの開口部に相当する酸化膜の部 分のレジストを露光して除去し、次にHFでマスクの開 口部に相当する酸化膜の部分を除去し、それからレジス トの残りを洗い落とす。

【0024】次に、マスク14をした状態でシリコン基 板10にKOHで異方性のエッチングを行い、シリコン 基板10の表面に複数の穴16を形成する。次に、図2 に示すように、マスク14をした状態でシリコン基板1 OにHFと硝酸の混合液で等方性のエッチングを行い、 シリコン基板10の表面の穴16をさらに深くする。図 1の状態でさらに異方性のエッチングを続けても穴16 は大きくならないが、図2に示すように等方性のエッチ ングを行うと穴16がさらに大きく、深くなる。なお、 等方性のエッチングはシリコン基板10のマスク14の 下の部分へも広がる。

【0025】こうして、深くなった穴16を有するシリ コン基板10をバンプ形成用板部材20として使用する ことができる。シリコン基板10の穴16をさらに深く したい場合には、図2の等方性のエッチングを行った後 に、図3に示すように、さらに異方性のエッチング及び 等方性のエッチングを行う。これによって、穴16はさ らに深くなる。異方性のエッチング及び等方性のエッチ ングをさらに繰り返すことができる。それによって、エ ッチングがシリコン基板10のマスク14の下の部分へ 広がるのを最小にしつつ、穴16がさらに深くなるよう にする。

【0026】さらに、図4に示すように、異方性のエッ

40

シリコン基板10の穴16の中心付近の先端にさらに嘴状の細い深い穴18を形成する。細い深い穴18はシリコン基板10の表面12とは反対側の表面22に開口するようにしてもよい。ただし、細い深い穴18は反対側の表面22に開口しなくてもよい。

【0027】なお、CF4 やCHF3 を使用した異方性のドライエッチングの場合の穴16の深さは、KOHを使用した異方性のウェットエッチングの場合の穴16の深さよりもいくらか深くなる。従って、等方性のエッチングの後で、異方性のドライエッチングを行うと、細い 10深い穴18ができる(図では誇張して示されている)。また、異方性のウェットエッチング及びドライエッチングと、等方性のエッチングとを組合せて用いることもできる。

【0028】こうして、図3のシリコン基板10及び図4のシリコン基板10をバンプ形成用板部材20として使用することもできる。また、図3及び図4において、シリコン基板10の穴16のリップ部のある表面12とは反対側の表面22を研削し、研削後の表面が24で示す部位になって、穴16の先端が反対側の表面24に露出するようにする。このようにすることによって、バンプ形成用板部材20を使用するときに、穴16の先端が、ガス抜き穴として作用する。図2のシリコン基板10の反対側の表面22を同様に研削してもよい。

【0029】図5及び図6は、図1の工程において、シリコン基板10の表面12を<100>の結晶面とした場合の穴16の形状を示す図である。この場合、穴16は四角錐状の形状になる。そして、この四角錐状の形状の穴16は、さらに等方性のエッチング及び異方性のエッチングを繰り返しても、全体的に丸みをおびつつ四角錐状の形状を維持し、そして深くなる。

【0030】図7及び図8は、図1の工程において、シリコン基板10の表面12を<110>の結晶面とした場合の穴16の形状を示す図である。この場合、穴16のリップ部は四角形形状であり、且つ穴16は直線状の最深部16の両側に斜面16b、16cが延びる楔形の底部を有する形状をしている。四角形のリップ部の対角線上にある2つの角から直線状の最深部16の各端部へ垂直に、辺16dが延びる。そして、この穴16も、さらに等方性のエッチング及び異方性のエッチングを繰り返しても、全体的に丸みをおびつつ元の形状を維持し、そして深くなる。

【0031】図9から図11は、図2から図4のバンプ形成用板部材20を使用してはんだバンプを形成する例を示している。図9に示すように、スキージ26を使用してはんだペースト28をバンプ形成用板部材20の表面12の穴16に充填する。穴16は単純化した形状で示されており、且つ穴16の先端がバンプ形成用板部材20の反対側の表面22(24)に開口するように形成されている。はんだペースト28の充填時には、バンプ

形成用板部材20の反対側の表面22に支持板30が重ねて使用され、はんだペースト28が穴16の先端から流れ出ないようになっている。

【0032】穴16間のビッチは例えば $200\mu$ mであり、穴16のリップ部の一辺の長さは $180\mu$ mである。これに対して、穴16の深さ(この場合には研削後のシリコン基板10の厚さ)は例えば0.2mである。使用に際しては、シリコン基板10のマスク14は除去される。はんだペースト28は、はんだクリームにはんだ粒子を混合したものであり、はんだ粒子の大きさは例えば $15\sim30\mu$ mの直径である。穴16の先端の開口部の大きさは例えば $30\mu$ mである。

【0033】図10においては、バンプ形成用板部材20とシリコンチップ等の電子部品32とを重ね合わせ、バンプ形成用板部材20の穴16と電子部品32の電極パッド34と位置合わせする。それから、バンプ形成用板部材20及び電子部品32をはんだの融点よりも30℃程度高い温度まで加熱し、はんだペースト28中のはんだを溶かしてバンプ形成用板部材20から電子部品32へ転写する。

【0034】バンプ形成用板部材20を加熱すると、穴16の中にあったはんだペースト28中のはんだが溶けて、表面張力により丸くなり、図11に示すようにはんだボール36となり、はんだボール36が電子部品32の電極パッド34に付着する。また、バンプ形成用板部材20を加熱すると、はんだペースト28中の揮発成分がガスとなって吹き出す。吹き出したガスは穴16の先端の開口部から抜ける。一方、穴16の先端が開口していないと、ガスは逃げ場がないので、バンプ形成用板部材20と電子部品32がバンプ形成用板部材20から浮いて、ペーストと電極パットがはなれる。

【0035】図11に示すように、電子部品32をバンプ形成用板部材20から離すと、はんだボール36が電子部品32の電極パッド34に付着してバンプとなる。図12から図15は、図2から図4のバンプ形成用板部材20を使用してはんだバンプを形成する他の例を示している。図12に示すように、スキージ26を使用してはんだベースト28をバンプ形成用板部材20の表面の穴16に充填する。はんだベースト28の充填時には、バンプ形成用板部材20の反対側の表面22に支持板30が重ねて使用され、はんだペースト28が穴16の先端から流れ出ないようになっている。

【0036】図13においては、バンプ形成用板部材20を加熱すると、穴16の中にあったはんだペースト28中のはんだが溶けて、表面張力により丸くなり、はんだボール36となる。この場合には、穴16の先端は必ずしも開口している必要はない。図14においては、バンプ形成用板部材20とシリコンチップ等の電子部品32とを重ね合わせ、バンプ形成用板部材20の穴16の

50

40

はんだボール36と電子部品32の電極パッド34と位置合わせする。バンプの転写圧力は例えば5から10g/バンプ程度とする。それから、バンプ形成用板部材20及び電子部品32をはんだの融点よりも30℃程度高い温度まで加熱し、はんだボール36をバンプ形成用板部材20から電子部品32へ転写する。図15に示すように、電子部品32をバンプ形成用板部材20から離すと、はんだボール36が電子部品32の電極パッド34に付着してバンプとなる。

【0037】図16から図19は、図2から図4のシリ 10 コン基板10を、バンプ形成用板部材20として使用するのではなく、金属のバンプ形成用板部材を作るためのオリジナルとして使用する例を示している。図2から図4のシリコン基板10は、図1に示したように、結晶性の板であるシリコン基板10にマスク14を形成して、異方性のエッチングを行ってシリコン基板10の表面に複数の穴16を形成してなるものである。また、異方性のエッチングを行った後に等方性のエッチングを行い、さらに、異方性のエッチング及び等方性のエッチングを繰り返して行ったものとしてもよい。穴16は貫通穴で 20 あっても、盲穴であってもよい。

【0038】図16においては、シリコン基板10を図示しないメッキ槽中に挿入し、シリンコ基板10を一方の電極とし、シリコン基板10にニッケル又は42アロイをメッキする。こうして、穴16を有するシリコン基板10と補完的な形状のレプリカ40がシリコン基板10の上に形成される。レプリカ40は例えば100μm・程度の厚さのニッケル又は42アロイの層からなる。

【0039】図17においては、レプリカ40をシリコン基板10から取り外した後、レプリカ40を金属のバ 30ンプ形成用板部材42を作るための型として使用する。レプリカ40を図示しないメッキ槽中に挿入し、レプリカ40を一方の電極とし、レプリカ40にニッケル又は42アロイをメッキする。こうして、レプリカ40と補完的な形状の金属のバンプ形成用板部材42がレプリカ40の上に形成される。

【0040】図18においては、金属のバンプ形成用板部材42をレプリカ40から取り外す。金属のバンプ形成用板部材42はシリコン基板10の表面12と同様の表面44を有し表面にはんだとはがれやすくするための40クロムメッキをほどこされ、この表面44には穴16と同様の形状の穴46が形成されている。金属のバンプ形成用板部材42は図9から図15に示したシリコン基板からなるバンプ形成用板部材20と同様にして電子部品32にはんだバンプを形成するために使用される。

42が薄くて柔らかいので、金属のバンプ形成用板部材42に例えばパラフィン等の支持板48をあてがった状態で研削を行う。こうして作られた金属のバンプ形成用板部材42は、歪んだ面へのバンプ形成を可能とし、且つ長い寿命を提供する。

10

#### [0042]

うに、電子部品32をバンプ形成用板部材20から離すと、はんだボール36が電子部品32の電極パッド34に付着してバンプとなる。 グを行うことにより、バンプ形成用板部材の穴をより深く形成でき、よってバンプ形成用板部材を使用して、電コン基板10を、バンプ形成用板部材20として使用するのではなく、金属のバンプ形成用板部材を作るためのオリジナルとして使用する例を示している。図2から図4のシリコン基板10は、図1に示したように、結晶性 (発明の効果)以上説明したように、本発明によれば、結晶性の板に異方性のエッチングを行うことにより、バンプ形成用板部材の穴をより深く下記のでき、よってバンプ形成用板部材を使用して、電子部品に微細なピッチで配列され且つ十分な大きさをもつバンプを形成することができる。また、一定の形状で、微小なピッチで配置された穴を有する金属のバンプ形成

## 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施例のバンプ形成用板部材を製造する製造方法の異方性のエッチング工程を示す図である。

【図2】図1の異方性のエッチング工程の後で等方性の エッチングを行う工程を示す図である。

【図3】図2の等方性のエッチング工程の後で異方性の エッチングと等方性のエッチングを行う工程を示す図で ある。

【図4】図3の異方性のエッチングと等方性のエッチングを行う工程において結晶性の板の穴の中心付近の先端にさらに嗜状の細い深い穴を形成することを示す図である。

【図5】異方性のエッチングを行った結晶性の板の平面 図である。

【図6】図5の結晶性の板の断面図である。

【図7】異方性のエッチングを行った結晶性の板の他の 例の平面図である。

【図8】図7の結晶性の板の図解的斜視図である。

【図9】バンプ形成用板部材の使用例を示し、バンプ形成用板部材の穴にはんだペーストを充填する工程を示す図である。

【図10】図9のバンプ形成用板部材と電極パッドを有する電子部品とを重ね合わせはんだを転写する工程を示す図である。

【図11】はんだボールが転写された電子部品を示す図である。

【図12】バンプ形成用板部材の他の使用例を示し、バンプ形成用板部材の穴にはんだペーストを充填する工程を示す図である。

【図13】図12のバンプ形成用板部材を加熱してはんだボールを形成する工程を示す図である。

【図14】図13のバンプ形成用板部材と電極パッドを 有する電子部品とを重ね合わせはんだを転写する工程を 示す図である。

【図15】はんだボールが転写された電子部品を示す図である。

(7)

11

【図16】図2から図4のシリコン基板を使用して金属のバンプ形成用板部材を作る列を示し、レブリカを作る工程を示す図である。

【図17】図16のレプリカを使用して金属のバンプ形成用板部材を作る工程を示す図である。

【図18】金属のバンプ形成用板部材を示す図である。

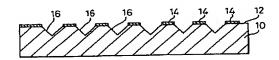
【図19】金属のバンプ形成用板部材の穴のリップ部とは反対側の表面を研削する工程を示す図である。

【図20】深い穴をもったバンプ形成用板部材を示す図である。

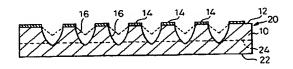
【図21】従来のシリコン板からなるバンプ形成用板部 材を示す図である。

【図22】従来の一様な断面の穴をもったバンプ形成用 板部材を示す図である。

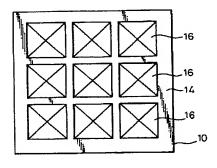
[図1]



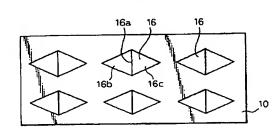
[図3]



[図5]



[図7]



12

【図23】従来の一様な断面の貫通穴をもったバンプ形成用板部材ではんだペーストを電子部品に転写する工程を示す図である。

### 【符号の説明】

10…シリコン基板

14…マスク

16…穴

18…嘴状の細い深い穴

20…バンプ形成用板部材

10 32…電子部品

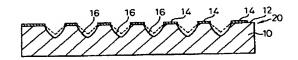
3 4…電極パッド

40…レプリカ

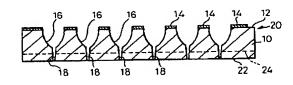
42…金属のバンプ形成用板部材

4.6…穴

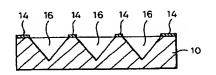
[図2]



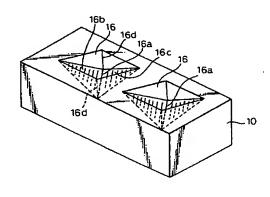
【図4】

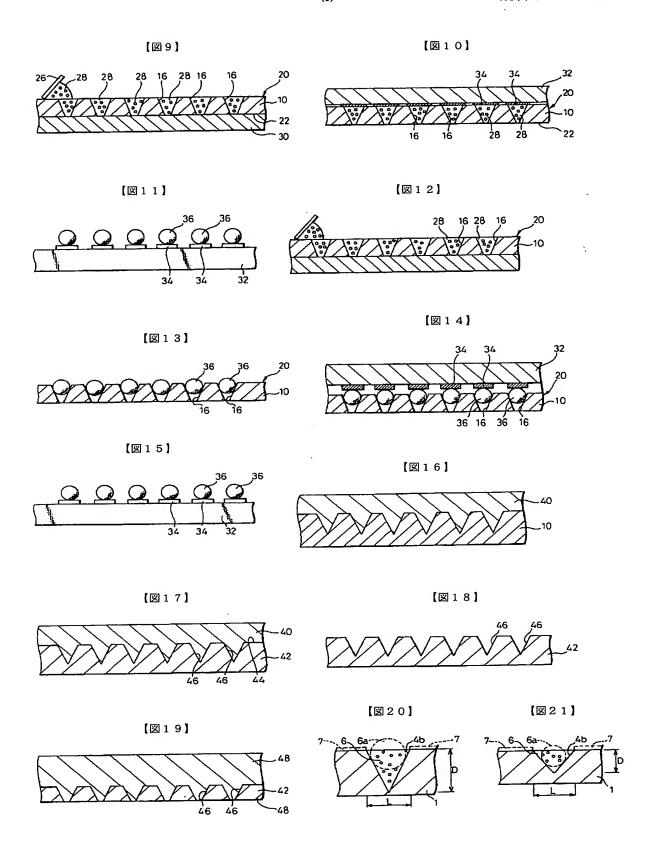


【図6】

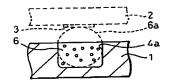


【図8】

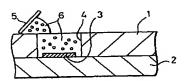




【図22】



## 【図23】



## フロントページの続き

(72) 発明者 吉川 政廣 神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番 1号 富士通株式会社内 (72) 発明者 大竹 幸喜 神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番

1号 富士通株式会社内

(72) 発明者 河西 純一 神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番 1号 富士通株式会社内